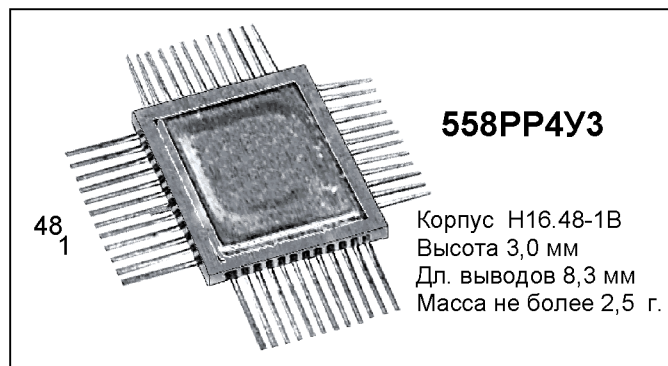


**64К (8Кx8) РЕПРОГРАММИРУЕМОЕ ПЗУ
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТИРАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ**

NМОП технология

Репрограммируемое постоянное запоминающее устройство с электрической записью-стиранием информации предназначено для построения энергонезависимой памяти микро-ЭВМ, систем промышленной автоматики, связи и измерительной техники.

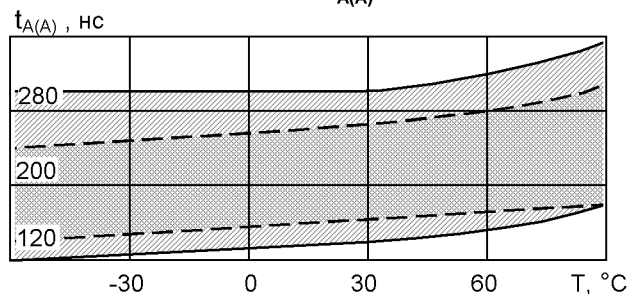
- время выборки адреса 400нс;
- напряжение питания 5В ± 10%;
- напряжение перепрограммирования 16В ± 0,5В;
- возможно перепрограммирование в диапазоне температур;
- имеется возможность распространения стойкости к спецвоздействиям;
- допустимое значение статического потенциала не более 150В.



НАДЕЖНОСТЬ

Наработка, ч	$t_{и}$	100 000
Срок хранения, лет	$t_{хр}$	25

ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ $t_{A(A)}$ от T



НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

1	U_{PR}	Напряжение программирования
2-4, 10-15, 36, 38, 39, 46	A0-A12	Вход адресный
20-22, 24-28	D0-D7	Вход-выход
35	CE	Вход сигнала разрешения обращения
23	U_{SS}	Земля
37	OE	Вход сигнала разрешения выхода
5-9, 16-19, 29-34, 40-45	-	Не используются
47	WR/RD	Вход сигнала записи-считывания
48	U_{CC}	Напряжение питания

ДОПУСТИМЫЕ ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

МЕХАНИЧЕСКИЕ

Механические удары, g	1500
Линейное ускорение, g	30000
Вибрация 1 - 5 000 Гц, g	40
Устойчивость к воде и спирто-бензиновой смеси	1:1

КЛИМАТИЧЕСКИЕ

Диапазон рабочих температур, °C	от - 60 до 85
Изменение температуры среды, °C	от - 60 до 125
Повышенная влажность при T = 35 °C, %	до 98
Температура пайки, °C	235 ± 5
Продолжительность, с	2 ± 0,5

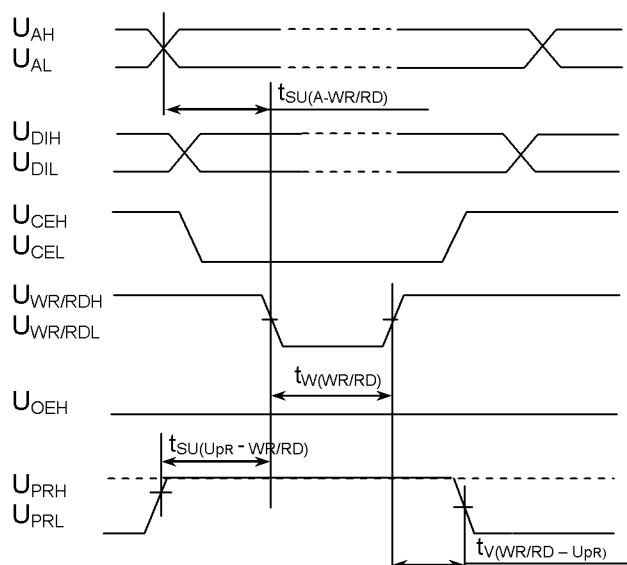
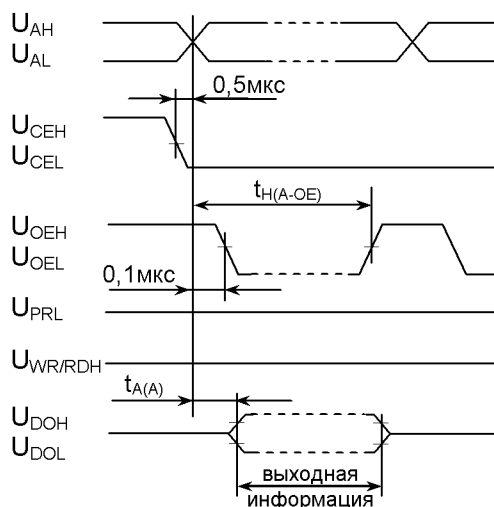
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ($U_{CC} = 5 \text{ В} \pm 10\%$)

Символ	Параметр	T, °C	558PP4У3
U_{DOL}	Напряжение низкого уровня сигнала выходной информации, В ($I_{DOL} = 1,6 \text{ мА}$)	от - 60 до 85	$\leq 0,4$
U_{DOH}	Напряжение высокого уровня сигнала выходной информации, В ($I_{DOH} = 0,1 \text{ мА}$)	от - 60 до 85	$\geq 2,4$
I_{CC}	Ток потребления, мА	25, 85 - 60	≤ 60 ≤ 80
I_{LI}	Ток утечки по каждому входу (A, CE, OE, WR/RD), мкА	от - 60 до 85	≤ 10
$I_{LI/O}$	Ток утечки на входах-выходах, мкА	от - 60 до 85	≤ 10
$t_{A(A)}$	Время выборки адреса, мкс	25 - 60, 85	$\leq 0,35$ $\leq 0,40$
$t_{A(CE)}$	Время выборки разрешения обращения, мкс	25 - 60, 85	$\leq 0,35$ $\leq 0,40$
$t_{A(OE)}$	Время выборки разрешения выхода, мкс	25 - 60, 85	$\leq 0,15$ $\leq 0,20$
t_{SG1}^*	Время хранения информации при отключённом питании, ч	от - 60 до 85	$\geq 25\ 000$
t_{SG2}^{**}	Время хранения информации при включённом питании, ч	от - 60 до 85	$\geq 15\ 000$
C_I	Входная ёмкость по каждому выводу (A, CE, OE, WR/RD), пФ	от - 60 до 85	≤ 10
$C_{I/O}$	Ёмкость входа-выхода, пФ	от - 60 до 85	≤ 30
N_{CY}	Количество циклов перепрограммирования,	от - 60 до 85	$\geq 10\ 000$

* При количестве циклов перепрограммирования от 1 до 10^3 время хранения информации при отключённом питании t_{SG1} не менее 87 600 ч. (10 лет), при этом допускается работа в режиме «считывания информации» при условии нахождения под напряжением не более 5000 ч.

** При количестве циклов перепрограммирования от 1 до 10^3 в диапазоне рабочих температур среды от минус 60 °C до 85°C время хранения информации при включённом питании t_{SG2} не менее 25000 ч.

*** Уровень дефектности при перезаписи информации после 10^3 циклов не превышает 2,5%.

ДИАГРАММА РЕЖИМА ЗАПИСИ

ДИАГРАММА РЕЖИМА СЧИТЫВАНИЯ


Длительность сигнала записи - стирания: при стирании 100 мс $\pm 10\%$, при записи 10 мс $\pm 10\%$.